



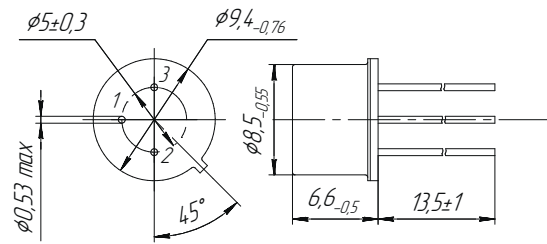
2Т630А, 2Т630Б

ЮФ3.365.043 ТУ

аналог 2N2405

Планарные транзисторы

Ключевые и линейные схемы аппаратуры специального назначения.
 $T_{\text{экспл}}: -60^{\circ}\text{C} \dots +125^{\circ}\text{C}$



- 1 — база
- 2 — эмиттер
- 3 — коллектор

Металлостеклянный корпус КТ-2-7 (ТО-39)

№ п/п	Наименование параметра, единица измерения (режим измерения при $T_{\text{окр. ср.}} = +25^{\circ}\text{C}$)	Условное обозначение	Значение параметров			
			2Т630А		2Т630Б	
			не менее	не более	не менее	не более
1.	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{\text{КБ max}}$	120	-	120	-
2.	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор – эмиттер, В ($R_{\text{БЭ}} \leq 3 \text{ КОМ}$)	$U_{\text{КЭ max}}$	120	-	120	-
3.	Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер – база, В	$U_{\text{ЭБ max}}$	7	-	7	-
4.	Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	$I_{\text{К max}}$	-	1	-	1
5.	Статический коэффициент передачи тока, ($U_{\text{КЭ}} = 10 \text{ В}, I_{\text{К}} = 0,15 \text{ А}$)	$h_{21Э}$	40	120	80	240
6.	Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_{\text{К}} = 0,15 \text{ А}, I_{\text{Б}} = 0,015 \text{ А}$)	$U_{\text{КЭ нас}}$	-	0,3	-	0,3
7.	Граничная частота коэффициента передачи тока, МГц	$f_{\text{гр}}$	50	-	50	-
8.	Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_{\text{К}} = +25^{\circ}\text{C}$, Вт	$P_{\text{К max}}$	-	0,8	-	0,8

Возможна поставка в бескорпусном исполнении разделенными или не разделенными на кристаллы

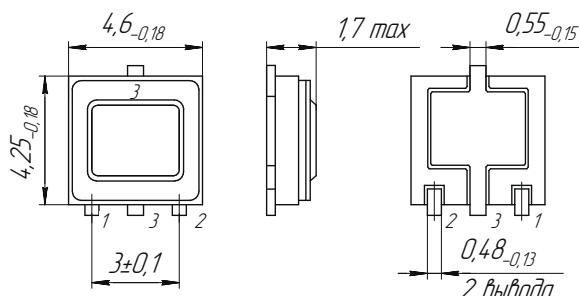
1.1.2. БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ N-P-N ТИПА

2Т630А9, 2Т630Б9

АЕЯР. 432140.546 ТУ

Эпитаксиально - планарные транзисторы

Ключевые и линейные схемы аппаратуры специального назначения.
 $T_{\text{экспл}}$: - 60°C ... +125°C



- 1 — база
- 2 — эмиттер
- 3 — коллектор

Металлокерамический корпус 4601.3-1 для поверхностного монтажа

№ п/п	Наименование параметра, единица измерения (режим измерения при $T_{\text{окр. ср.}} = +25^{\circ}\text{C}$)	Условное обозначение	Значение параметров			
			2Т630А9		2Т630Б9	
			не менее	не более	не менее	не более
1.	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{\text{КБ max}}$	120	-	120	-
2.	Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор – эмиттер, В ($R_{\text{БЭ}} \leq 3 \text{ кОм}$)	$U_{\text{КЭ max}}$	120	-	120	-
3.	Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер – база, В	$U_{\text{ЭБ max}}$	7	-	7	-
4.	Максимально допустимый постоянный ток коллектора, А	$I_{\text{К max}}$	-	1	-	1
5.	Статический коэффициент передачи тока, ($U_{\text{КЭ}} = 10 \text{ В}$, $I_{\text{К}} = 0,15 \text{ А}$)	$h_{21Э}$	40	120	80	240
6.	Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, В ($I_{\text{К}} = 0,15 \text{ А}$, $I_{\text{Б}} = 0,015 \text{ А}$)	$U_{\text{КЭ нас}}$	-	0,3	-	0,3
7.	Граничная частота коэффициента передачи тока, МГц ($U_{\text{КЭ}} = 10 \text{ В}$, $I_{\text{Э}} = 0,2 \text{ А}$, $f_{\text{изм}} = 10 \text{ МГц}$)	$f_{\text{гр}}$	50	-	50	-
8.	Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_{\text{К}} = +25^{\circ}\text{C}$, Вт	$P_{\text{К max}}$	-	4,8	-	4,8

Возможна поставка в бескорпусном исполнении разделенными или не разделенными на кристаллы

1. 1. 2. БИПОЛЯРНЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ N-P-N ТИПА